

Обозначение	Характеристика процесса	Применение, элементная база	PDF
<input type="checkbox"/> <u>15 В, 5,0 мкм КМОП, 1 ПКК, 1 металл, несамосовмещенный затвор</u>	Количество фотолитографий, шт. 9 Проектная норма, мкм 5,0 Подложка: 460 КЭФ4.5 (100) Глубина P-кармана, мкм 10 Подзатворный SiO ₂ , Å 950 Межслойный диэлектрик СТФСС Длина канала: NMOS/PMOS, мкм 5/6 шаг ПКК, мкм 5.5 контакты, мкм ø 2 шаг по металлу, мкм 8	Логические ИС малой и средней степени интеграции с Ep до 20В. NMOS: Vtn= 1.1 В, Usd >27 В PMOS: Vtp= -1.0 В, Usd >29 В	
<input type="checkbox"/> <u>5 В, 1,5 мкм КМОП, 1 ПКК, 2 металла</u>	Количество фотолитографий, шт. 14 Проектная норма, мкм 1.5 Подложка: КЭФ4.5 Глубина N/P-кармана, мкм 5/5 Межслойный диэлектрик: БФСС Межуровневый диэлектрик: ПХО Подзатворный SiO ₂ , Å 245 Длина канала: NMOS/PMOS, мкм 1.4/2.0 N LDD- стоки шаг ПКК, мкм 3.4 контакты 1, мкм 1.5*4,5 шаг металл 1, мкм 6.0 контакты 2, мкм 3.0*4,5 шаг металл 2, мкм 9,5	Логические ИС малой и средней степени интеграции с Ep до 5 В NMOS: Vtn= 0.8 В, Usd >12 В PMOS: Vtp= -0.8 В, Usd >12 В	
<input type="checkbox"/> <u>5 В, 2 мкм КМОП, 1 ПКК, 1 металл</u>	Количество фотолитографий, шт. 11 Проектная норма, мкм 2.0 Подложка: КЭФ 4.5, ь 2 кармана Глубина N/P-кармана, мкм 6/7 Подзатворный SiO ₂ , Å 425/300 Межслойный диэлектрик: БФСС Длина канала: NMOS/PMOS, мкм 2.5 шаг ПКК, мкм 4.5 контакты, мкм 2.4*2.4 шаг металл, мкм 8.5	Логические ИС малой и средней степени интеграции с Ep до 5 В. NMOS: Vtn= 0.6/0.5 В, Usd >12 В PMOS: Vtp= -0.7 В/-0.5, Usd >14 В	
<input type="checkbox"/> <u>5 В, 1,6 мкм КМОП, 2 ПКК, 1 металл, ЭСППЗУ пл. 150 мм</u>	Количество фотолитографий, шт. 17 Проектная норма, мкм 1.6 Подложка: КДБ-12 2 кармана Глубина N/P-кармана, мкм 5/6 Подзатворный SiO ₂ , Å 425 Туннельный SiO ₂ , Å 77 Межсл. диэлектрик-1: Si ₃ N ₄ , Å 350 Межсл. диэлектрик-2: БФСС, Å 7000 Встроенные транзисторы Длина канала: NMOS/PMOS низковольтные транзисторы, мкм 2.4 высоковольтные транзисторы, мкм 3.6 шаг ПКК1, мкм 3.2 шаг ПКК2, мкм 4.2 контакты, мкм ø1.2 шаг по металлу, мкм 4.4	ЭСППЗУ средней степени интеграции с Ep от 2,4 В до 6 В NMOS: Vtn=[0,65±0,25]В Usd >=12 В PMOS: Vtp=[0,8±0,2]В Usd ≤-12 В HV-NMOS: Vtn=[0,45±0,15]В Usd ³ 17В HV-PMOS: Vtp=[0,8±0,2]В Usd ≤-16 В	
<input type="checkbox"/> <u>5 В, 1,2 мкм КМОП, 2 ПКК, 2 металла, ЭСППЗУ пл. 150 мм</u>	Количество фотолитографий, шт. 23 (с метками) Проектная норма, мкм 1.2 Подложка: КДБ-12, 2 кармана Глубина N/P-кармана, мкм 5/6 Подзатворный SiO ₂ : низковольтные транзисторы, Å 250 высоковольтные транзисторы, Å 350 Туннельный SiO ₂ , Å 77 Межсл. диэлектрик-1: Si ₃ N ₄ , Å 350 Межсл. диэлектрик-2: БФСС, Å 7000 Межуровневый диэлектрик: ПХО+SOG+ПХО Длина канала: низковольтные NMOS/PMOS, мкм 1.4/1.6 высоковольтные NMOS/PMOS, мкм 2.6/2.6 N и P LDD- стоки, Встроенные транзисторы, шаг ПКК1, мкм 3.2 шаг по ПКК2 без контакта, мкм 2.4 шаг по ПКК2 с контактом, мкм 4,6 контакты-1, мкм ø 1.2 шаг по металлу 1 без контакта, мкм 3.2	ЭСППЗУ большой степени интеграции с Ep от 2,4 В до 6 В LV NMOS: Vtn=[0.4-0,8]В Usd ³ 12 В LV PMOS: Vtp=[0.5-0,9]В Usd ≤-12 В HV- NMOS: Vtn=[0,3-0,6]В Usd ³ 17 В HV- PMOS: Vtp=[0,6-1,0]В Usd ≤-15 В	

<input type="checkbox"/> <u>1.5 В, 1.6 мкм КМОП, 1 ПКК, 1 металл, низопороговый пл. 150 мм</u>	<p>шаг по металлу 2 с контактом, мкм 4,4 контакты 2, мкм \varnothing 1.4 шаг по металлу 2 без контакта, мкм 4.4 шаг по металлу 2 с контактом, мкм 4,8</p> <p>Количество фотолитографий, шт. 11</p> <p>Проектная норма, мкм 1.6 Подложка: КДБ12, 2 кармана Глубина N/P-кармана, мкм 5/6 Подэзворный SiO₂, Å 300 Межслойный диэлектрик – БФСС Длина канала: NMOS/PMOS, мкм 2.0 шаг ПКК, мкм 3.2 контакты, мкм \varnothing 1.5 шаг металла, мкм 3.6</p>	<p>Цифровые ИМС средней степени интеграции для ЭНЧ и микрокалькуляторов Епит от 1.5 В до 3 В. NMOS: Vtn= 0.5 В , Usd >10 В PMOS: Vtp= -0.5 В, Usd >10 В</p>
<input type="checkbox"/> <u>5 В, 1.5 мкм КМОП, 1 ПКК, 1 металл, пл. 150 мм</u>	<p>Количество фотолитографий, шт. 16</p> <p>Проектная норма, мкм 1.5</p> <p>Подложка: КДБ12, 2 кармана Глубина N/P-кармана, мкм 5/6 Межслойный диэлектрик: БФСС Подэзворный SiO₂, Å 250 Межслойный диэлектрик: БФСС Встроенные транзисторы в ПЭУ Скрытые контакты длина канала NMOS/PMOS, мкм 1.5 N и P LDD- стоки шаг ПКК, мкм 2.5 контакты, мкм \varnothing 1.5 шаг по металлу, мкм 3.5</p>	<p>Цифровые ИМС. микроконтроллеры с Епит=5 В NMOS: Vtn= 0.6 В, Usd >10 В PMOS: Vtp= 1.0В, Usd >13 В</p>
<input type="checkbox"/> <u>5 В, 1.5 мкм КМОП, 1 ПКК, 1 Металл, ПКК-резисторы пл. 150 мм</u>	<p>Количество фотолитографий, шт. 17</p> <p>Проектная норма, мкм 1.5</p> <p>Подложка: КДБ12, 2 кармана Глубина N/P-кармана, мкм 5/6 ПКК резисторы Р-типа Биполярный вертикальный NPN транзистор Подэзворный SiO₂, Å 250 Межслойный диэлек трик: БФСС длина канала NMOS/PMOS, мкм 1.7 N и P LDD- стоки шаг ПКК, мкм 2.5 контакты, мкм \varnothing 1.3 шаг по металлу, мкм 3.5</p>	<p>Схемы контроллеров напряжения питания NMOS: Vtn= 0.5 В , Usd >10 В PMOS: Vtp= 0.5 В, Usd >10 В</p>
<input type="checkbox"/> <u>3-5 В, 0.8 мкм КМОП, 1 ПКК (2ПКК), 2 металла пл. 150 мм</u>	<p>Кол-во фотолитографий, шт. 14 [16]</p> <p>Проектная норма, мкм 0.8</p> <p>Подложка: КЭФ4.5 или КДБ12, 2 кармана Глубина N/ P карманов, мкм 4/4 Межслойный диэлектрик: БФСС Подэзворный SiO₂, Å 130 / 160 длина канала NMOS/PMOS, мкм 0.9/1.0 N и P LDD- стоки металл I Ti-TiN/Al-Si/TiN шаг ПКК, мкм 1.9 контакты 1, мкм \varnothing 0.9 шаг по металлу 1, мкм 2.2 металл 2 Al-Si/TiN контакты 2, мкм \varnothing 0.9 шаг по металлу 2, мкм 2.4</p>	<p>ИС для телефонии, заказные ИС с Епит. от 3 В до 5 В NMOS: Vtn=0.6 В, Usd >10 В PMOS: Vtp=-0.7 В, Usd >10 В</p>
<input type="checkbox"/> <u>3-5 В, 0.8 мкм КМОП, 1 ПКК (2ПКК), 2 металла пл. 200 мм</u>	<p>Кол-во фотолитографий, шт. 14 [16]</p> <p>Проектная норма, мкм 0.8</p> <p>Подложка: КЭФ4.5 или КДБ12, 2 кармана Глубина N/ P карманов, мкм 4/4 Межслойный диэлектрик: SACVD SiO₂ + ПХ ТЭОС, мкм 1,05 Подэзворный SiO₂, Å 130 / 160 длина канала NMOS/PMOS, мкм 0.9/1.0 N и P LDD- стоки металл I Ti/AlCu / Ti /TiN шаг ПКК, мкм 1.9 контакты 1 (заполнены W), мкм 0.7 шаг по металлу 1, мкм 2.2 металл 2 /Ti/AlCu контакты 2 (заполнены W), мкм 0.7 шаг по металлу 2, мкм 2.4</p>	<p>ИМС для телефонии, заказные ИМС с Епит от 3 до 5 В NMOS: Vtn=0.6 В, Usd >10 В PMOS: Vtp=-0.7 В, Usd >10 В</p>
<input type="checkbox"/> <u>1.5 В, 3.0 мкм КМОП, 1 ПКК, 1 металл, несамосовмещенный затвор</u>	<p>Количество фотолитографий, шт. 9</p> <p>Проектные нормы, мкм 3,0 – 5,0</p> <p>Подложка: КЭФ4.5 Глубина P-кармана, мкм 6-8 Подэзворный SiO₂, Å 800 Межслойный диэлектрик – СТФСС</p>	<p>Часовые ИС малой и средней степени интеграции с Еп до 1.5В. NMOS: Vtn= 0.7/0.5 В , Usd >8 В, Ic>4mA PMOS: Vtp= -0.7 В/-0.5, Usd >8 В, Ic>2mA</p>

	Длина канала: NMOS/PMOS, мкм		
	3		
	шаг ПКК, мкм		
	10		
	контакты,		
	мкм	5	
	шаг по металлу, мкм		
	12		
	Количество фотолитографий, шт.		
	11		
	Проектные нормы, мкм	2.0	
	Подложка:	КЭФ 4.5	
	Глубина N/P-кармана, мкм	6-	
	8		
	Подэпиторный SiO ₂ , Å		Логические ИС малой и средней степени интеграции
	425/300		с Eп до 5 В
	Межслойный диэлектрик:		NMOS: Vtn= 0.8-1.2В, Ic>4мА, Uпр>8 В
	БФСС		PMOS: Vtp= 0.8-1.2В, Ic>2мА, Uпр>8В
<input type="checkbox"/>	Длина канала:NMOS/PMOS, мкм	3-	
	4		
	шаг ПКК, мкм	10	
	контакты, мкм	4*4	
	шаг металл, мкм	10	
	Количество фотолитографий, шт.		
	11		
	Проектные нормы, мкм	1.2	
	Подложка:	КДБ12	
	Глубина N/P-кармана, мкм		
	5/6		
	Подэпиторный SiO ₂ , Å	250-	
	300		
	Межслойный диэлектрик: БФСС		КМОП БМК
<input type="checkbox"/>	Длина канала: NMOS/PMOS,		NMOS: Vtn= 0.7В, Ic>11.5мА, Uпр>12 В
	мкм	1.4/1.6	PMOS: Vtp= 0.8В, Ic>4.5мА, Uпр>12В
	шаг ПКК, мкм	2.8	
	контакты, мкм		
	1.6x1.6		
	шаг металл 1,		
	мкм	3.4	
	шаг металл 2,		
	мкм	3.0	
	Количество фотолитографий, шт.		
	11		
	Проектные нормы, мкм	1.2	
	Подложка:	КДБ12	
	Глубина N/P-кармана, мкм	5/6	КМОП БМК
<input type="checkbox"/>	Подэпиторный SiO ₂ , Å	250-300	NMOS: Vtn=1.0В, Ic>10мА, Uпр>12 В
	Межслойный диэлектрик:	БФСС	PMOS: Vtp= 1.0В, Ic>4.0мА, Uпр>12В
	Длина канала:NMOS/PMOS, мкм	2.0	
	контакты, мкм	2.0x2.0	
	шаг металл 1, мкм	8	
	шаг металл 2, мкм	10	

[ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ](#)

